# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-276045

(43)Date of publication of application: 09.11.1990

(51)Int.CI.

G11B 11/10

(21)Application number: 01-206934

(71)Applicant : OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

11.08.1989

(72)Inventor: MATSUBAYASHI NOBUHIDE

NAKANO OSAMU

(30)Priority

Priority number: 64 14003

Priority date : 25.01.1989

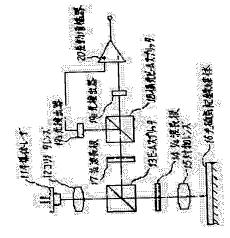
Priority country: JP

# (54) MAGNETO-OPTICAL REPRODUCING DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the C/N of a regenerative signal from dropping by making an elliptically polarized beams from a first optical means into the elliptically polarized beams, whose major axes are almost orthogonal to each other and which rotate in the same direction, according to the rotating direction, transmitting one of polarized components orthogonal to the almost major and minor axis directions of the elliptically polarized beams, reflecting the other, and obtaining transmitted beams and reflected beams.

CONSTITUTION: When the beams passing through an objective lens 15 is made incident on a magneto-optical recording medium 16, the reflected beams are kerr-rotated according to information recorded on the magneto-optical recording medium 16, namely the magnetized direction, and made incident on a beam splitter 13 again. Since an S polarized component exists in the incident beams, the phase of the beams is shifted by 90°, the rotated beams is made into the elliptically



polarized beams, which clockwise and counter-clockwise rotate, with the same size. Thereafter by passing through a 1/4 wavelength plate 17, the beams rotate in the same direction according to the rotating direction of the elliptically polarized beams, made into the elliptically polarized beams orthogonal to each other, next the transmitted and reflected beams are respectively made into opposite phase by a polarized beam splitter 18, and made incident on photodetectors 19a and 19b. Thus the C/N of the regenerative signal by the regulating error of the optical system can be prevented from dropping.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### ⑲ 日本 国特許庁(JP)

① 特 許 出 願 公 開

#### 平2-276045 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 5

個発

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月9日

G 11 B 11/10

明者

Z

7426-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

光磁気再生装置 60発明の名称

> 顧 平1-206934 创特

29出 願 平1(1989)8月11日

⑩平1(1989)1月25日繳日本(JP)勁特願 平1-14003 優先権主張

宜

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業 冶 個発 明者 中 野

株式会社内

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業株 の出 願人

式会社

松 林

外5名 暁秀 弁理士 杉村 **郊代 理 人** 

- 光磁気再生装置 1.発明の名称
- 2.特許請求の範囲
  - 1. 光磁気記録媒体に垂直方向に磁化されて記 録された情報を光学的に読み取る光磁気再生 装置において、前記光磁気記録媒体からの反 射光の偏光状態を、同じ方位、同じ大きさで、 磁化の向きに応じて右回り、左回りの楕円偏 光にする第1の光学手段と、この第1の光学 手段からの楕円偏光をその回転の向きに応じ て、長軸の方向がほぼ直交する同一方向に回 転する楕円偏光にする第2の光学手段と、こ の第2の光学手段からの楕円偏光のほぼ長軸 および短軸方向に直交する偏光成分の一方を 透過し、他方を反射する第3の光学手段とを 具え、この第3の光学手段での透過光および 反射光に基づいて情報を読み取るよう構成し たことを特徴とする光磁気再生装置。
  - 2: 前記第1の光学手段を、前記光磁気記録媒 体への入射光の偏光面を基準として方位0°

または90°に設定した1/4 波長板をもって構 成し、前記第2の光学手段を前記偏光面を基 準として方位45°または-45°に設定した 1/4 波長板をもって構成し、前記第3の光学 手段を偏光ビームスプリッタをもって構成し たことを特徴とする請求項1記載の光磁気再 生装置。

- 前記光磁気記録媒体からの反射光の光路中 に反射面を設け、この反射面にP偏光成分お よびS偏光成分間に90°の位相差を発生させ るコーティングを施して前記第1の光学手段 を構成したことを特徴とする請求項1または 2 記載の光磁気再生装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は光磁気再生装置に関する。

(従来の技術)

光磁気再生装置は従来種々のものが提案されて いる(例えば特開昭63-184936 号公報)。

第6図は従来の光磁気再生装置の構成を示すも

のである。この光磁気再生装置においては、半導へ体レーザ 1 からのレーザ光をコリメイイを経て光ビームスプリック 3 および対物レンズ 4 を経知した。 そが 2 を 2 を 3 および 1/2 被 長 を 5 に 投射 と 7 に 入射 させるよい 7 リック 7 に 入射 させるよう で 間 に 対して 22.5 に で は か で に 入射 させるように 構成されている。

第7図A~Cは、第6図に示した従来の光磁気 再生装置における各光路での偏光状態と、ジョーンズベクトルとを示すものである。第7図Aに示すように、半導体レーザ1からの出射光を直線偏光で、その振幅を1とすると、このレーザ光はビームスプリッタ3を第7図Bに示すように直線偏 光のまま透過し、その振幅はビームスプリッタ 3 での透過率をTpとすると、√Tpとなる。また、光 磁気記録媒体 5 での反射光は、光磁気記録媒体 5 での反射率をR、磁化の向きによるカー回転角を ± 8k とすると第7図Cに示すようになり、この 反射光がビームスプリック3で反射されると第7 図Dに示すようになる。なお、第7図Dにおいて RoおよびRsはそれぞれビームスプリック3でのP 偏光およびS偏光の反射率を示し、偏光状態はS 偏光の反射率を 100%として示してある。このビ ームスプリッタ3での反射光は、1/2 波長板6で 偏光面が45°回転されて第7図Bに示すようにな り、この光が偏光ビームスプリック7でP偏光成 分とS偏光成分とに分離されることにより、透過 光(P偏光)および反射光(S偏光)はそれぞれ 第1図Fおよび第7図Cに示すように、振幅が同 じでカー回転の向きにより逆相の信号となる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしなから、第6図に示した従来の光磁気再 生装置にあっては、1/2 波县板6の方位のずれに

- 4 -

- 3 <del>-</del>

より、再生信号のC/N が大きく影響を受けるため、 その調整の精度を厳しくする必要がある。

すなわち、第6図では1/2 波長板6を、その結晶の光学軸が半導体レーザ1からの直線偏光の方向に対して22.5°となるように網整して配置する必要があるが、その設定角度がαずれて22.5°+αとなると、偏光面の回転は45°+2αとなる。このとき、2つの光検出器8a、8bの出力差による依号光強度は、

RTp √ RpRs sin2 θ kcos4 α --- (1) となる。また、 2 つの光検出器 8 a . 8 b に入射 する平均の光強度の差動アンパランス量は、

RTp  $\sin 4\alpha$  (Rpcos<sup>2</sup>  $\theta$  k — Rssin<sup>2</sup>  $\theta$  k) --- (2)

上記(1)および(2)式から明らかなように、誤差αがあると、信号光強度は cos4αに比例して減小し、差動アンパランス量は sin4αに比例して増大することになる。このため、誤差αが微小であってもノイズが増大し、再生信号のC/N が低下することになる。

このように、第6図に示した従来の光磁気再生装置にあっては、1/2 波長板6の方位のずれによるC/Nの低下が大きいため、その調整の精度を厳しくする必要があり、これがため組立てが面倒と

なってコスト高になるという問題がある。

なお、上記の問題を解決する方法として、1/2 波長板を用いずに偏光ビームスプリッタ7を第6 図において光軸を中心に45°回転して配置することが考えられる。このようにすれば、調整誤した よる悪影響が上記の場合に比べ半分となり、よる悪影響が上記の場合に比べ半分となり、この場合には がって調整精度を半分にできるが、この場合向には は光ビームスプリッタ7での反射光が45°方向には はかるため、同一平面内に光学系を配置すること ができなくなり、光学系全体が大形になるという 不具合がある。

この発明は、上述した従来の問題点に着目してなされたもので、光学系の調整誤差による再生信号のC/Nの低下を軽減でき、したがって組立てを容易にでき、調整コストを低減できるよう適切に構成した光磁気再生装置を提供することを目的と

する.

〔課題を解決するための手段および作用〕

上記目的を達成するため、この発明では光磁気には妖なするため、この発明ではれた情報を連成す向に磁化気軽はおいたでは、前間に発生を開発されたで、、一個の大力のでは、一個の大力のでは、一個の大力の大力の大力の大力を受ける。

「一個の大力の大力を受ける。」の大力のは、一個の大力の大力をでは、の方のは、一個の大力の大力のでは、の方のは、一個の大力の大力を受ける。
「一個の第2の光学手段の大力を見いません。」の大力を反射する第3の光学手段とを異なる。
「一個報を読み取るよう構成する。

#### (実施例)

第1図はこの発明の第1実施例を示すものである。この実施例では、半導体レーザ11からのレーザ光をコリメータレンズ12、ビームスブリッタ13、

- 7 -

すように直線偏光(P偏光)のまま透過し、その振幅はピームスプリック13での透過率をTpとすると、√Tpとなる。したかって、このピームスプリック13での透過光が方位 0° の1/4 被 長板14を通っても S偏光成分が等であるため、第 2 図 C に示すようにその偏光状態は変化しない。

次に、1/4 被長板14を通った光光磁気記録媒体16に入射すると、その反射光は光磁気記録媒体16に記録されている情報すなわち磁化の向回転を受ける。なお、第2図Dに示すようにものの反射光が再次では、第2図Dに示すようによいの反射光が再を示す。この反射光はS偏光はS偏光はC入射するると、放射光にはかってと対象をである。この1/4 が存在するため位相が90°ずれ、したがってとりが存在するため位相が90°ずれ、したがってとりが存在した光は第2図Bに示せなる。この1/4 が存在した光は第2図Bに示せなる。この1/4 がの同じ大きさの楕円偏光体16からの反射光がピームスブリッタ13で反射されると、ピームスブリッタ13で反射さんの反射をで表と第2図Fに示すよびRsとと第2図Fに示けないRsとで表と第2図Fに表

1/4 波長板14および対物レンズ15を経て光磁気記録媒体16に投射し、その反射光を対物レンズ15、
1/4 波長板14、ピームスプリッタ13および1/4 波 長板17を経て偏光ピームスプリッタ18に入射させ、入るの透過光および反射光をそれぞれ光検出器19 a 。 19 b で受光してそれらの出力の差を差動増幅器20で検出して再生信号を得るようにする。ここで、1/4 波長板14はその結晶の光学軸の方位が、光磁気記録媒体16への入射光の偏光面に対うに配置光磁線は体16への入射光の偏光面方位が、光磁気記録媒体16への入射光の偏光面すなわち半導体レーザ11からのレーザ光の直線偏光の方向に対して45°となるように配置する。

以下、この実施例における動作を、第2図A~ 1に示す各光路での偏光状態およびジョーンズベクトルを参照しながら説明する。

第2図Aに示すように、半導体レーザ11からの 出射光を直線偏光で、その振幅を1とすると、こ のレーザ光はビームスプリッタ13を第2図Bに示

- 8 -

の形が変化する。なお、第2図ドではRs-1としているため、P偏光成分だけが小さくなって、楕円 の1/4 波 長板17を通ると、楕円 の後、方位45 の1/4 波 長板17を通ると、楕円 偏光の回転の向きに応じて、第2図Gに示すように同一方向に回転し、長軸の方向はなり、 橋光となる。ここで、楕円偏光の長軸の方向ははP偏光となる。ここで、楕円偏光の方向ははP偏光の方向にそれぞれ一致する。したがって、偏光に一ムスプリッタ18の透過光および反射光をそれぞれ受光はなり、 はいる透過光および反射光をそれぞれ受光 はなり、 はいる透過光および反射光をを動増幅器20で検出することにより再生信号が得られる。

次に、この実施例において、1/4 波長14および 17の方位の精度が、再生信号にどのように影響す るかについて説明する。

先ず、ビームスブリック13と光磁気記録媒体16 との間の1/4 波長板14が、方位0°から角度αだ けずれた場合を考えると、この場合の1/4 波長板 14のジョーンズマトリックスは、

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{cases} 1+i \cos 2\alpha & i \sin 2\alpha \\ i \sin 2\alpha & 1-i \cos 2\alpha \end{cases}$$

となる。この1/4 波長板14を一度通過した後、光 磁気記録媒体16により反射され、カー回転を受け て再び遭過すると、ジョーンズベクトルは、

i cos 
$$\theta$$
 k cos  $2\alpha$   
i cos  $\theta$  k sin  $2\alpha \pm \sin \theta$  k

となる。したかって、その後の光学系が理想的に 調整されているものとすると、2つの光検出器19a, 19b の出力差による信号光強度は、

RTp √ RpRs sin2θk cos2α ---(3) となり、(1)式に比べcos4αかcos2αとなって、织 整αによる信号の低下が小さくなる。また、2つ の光検出器19a、19bに入射する平均の光強度の差 動アンバランス量は発生せず、ノイズの増加もない。

次に、ビームスプリッタ13と偏光ビームスプリッタ18との間の1/4 波長板17が、方位45°から角

- 1 1 -

また、この実施例では2枚の1/4 波長板14, 17を 貼り合わせることができるので、光学系をコンパ クトにできる利点がある。

なお、以上の実施例では、 2 枚の1/4 被長板14 および17をそれぞれ方位0 \* および45 \* に配置するようにしたが、これらはそれぞれ方位90 \* および-45 \* に配置してもよい。

第4図はこの発明の第3実施例を示すものである。この実施例は、第1図において1/4 被長板14を配置する代わりにピームスプリッタ13の反射面13aに、光磁気記録媒体16からの反射光のP偏光成分およびS偏光成分間に90°の位相差を発生させるコーティング13bを施して同様の作用を行わせるようにしたものである。

コーティング13b は、ビームスプリッタ13の硝材がBK7 の場合には、例えば $T_1O_2$ および $S_1O_2$ の誘電体物質を交互に11層蒸着して構成する。このようにしてコーティング13b を構成すれば、例えば第  $1 \sim 4$  表に示す特性のもの、すなわち波長830nm人動角度45 で P 偏光成分(RP) と S 偏光成分(RS)

度αだけずれた場合を考える。この場合の信号光 強度は上記(3)式と同様に、cos 2αに比例して低 下する。また、差動アンバランス量は、

RTp sin<sup>2</sup> 2α(Rp cos<sup>2</sup>θk-Rs sin<sup>2</sup>θk) ---(4) となり、(2)式に比べsin4αがsin<sup>2</sup>2αとなってか なり小さくなる。

以上のように、この実施例によれば2枚の1/4 被長板14、17の方位が多少ずれても、再生信号の C/N に与える影響は第4図に示した従来例の半分以下となる。したがって、光学系の組立てが容易にでき、調整コストを低減することが可能となる。

第3図はこの発明の第2実施例を示すものであ

る。この実施例は、第1図において方位 0 ° の 1/4 被長板14をビームスプリッタ13と偏光ビームスプリッタ18との間に配置したもので、その他の構成は第1図と同様である。この実施例によれば、1/4 被長板14,17の方位のずれαによる影響は、2 枚とも、信号光強度についてはcos2αに比例し、差動アンバランス量については(4)式で表わされるようになるので、第1実施例と同様の効果がある。

- 1 2 -

との間に90°の位相差D(RP-RS) を持ち、反射率 特性がRP-17%、RS-96%のものを得ることがで \*\*\*

第 1 表

| 入射角度 44.8000(deg) |        |        |         |  |  |
|-------------------|--------|--------|---------|--|--|
| 波長 (nm)           | RP (%) | RS (%) | D (deg) |  |  |
| 820.0000          | 18.80  | 94.73  | -88.68  |  |  |
| 830.0000          | 17.82  | 95.77  | -90.43  |  |  |
| 840.0000          | 17.53  | 96.63  | -87.27  |  |  |

第2表

| 入射角度 45.2000(deg) |        |        |         |  |  |
|-------------------|--------|--------|---------|--|--|
| 波長 (nm)           | RP (%) | RS (%) | D (deg) |  |  |
| 820.0000          | 17.26  | 95.43  | -92.55  |  |  |
| 830.0000          | 16.56  | 96.38  | -91.89  |  |  |
| 840.0000          | 16.52  | 97.11  | -86.97  |  |  |

第3表

|                   | 2, 0 0 |        |         |  |  |  |
|-------------------|--------|--------|---------|--|--|--|
| 入射角度 45.0000(deg) |        |        |         |  |  |  |
| 彼長 (nm)           | RP (%) | RS (%) | D (deg) |  |  |  |
| 820.0000          | 18.02  | 95.08  | -90.75  |  |  |  |
| 822.0000          | 17.80  | 95.29  | -91.30  |  |  |  |
| 824.0000          | 17.60  | 95.50  | -91.62  |  |  |  |
| 826.0000          | 17.43  | 95.70  | -91.72  |  |  |  |
| 828.0000          | 17.29  | 95.89  | -91.60  |  |  |  |
| 830.0000          | 17.17  | 96.08  | -91.28  |  |  |  |
| 832.0000          | 17.09  | 96.26  | -90.77  |  |  |  |
| 834.0000          | 17.03  | 96.43  | -90.09  |  |  |  |
| 836.0000          | 17.00  | 96.59  | -89.26  |  |  |  |
| 838.0000          | 16.99  | 96.74  | -88.29  |  |  |  |
| 840.0000          | 17.02  | 96.88  | -87.20  |  |  |  |

第4表

| 波長 830.0000(nm) |        |        |         |  |
|-----------------|--------|--------|---------|--|
| 角度 (deg)        | RP (%) | RS (%) | D (deg) |  |
| 44.5000         | 18.84  | 95.27  | -88.69  |  |
| 44.6000         | 18.50  | 95.44  | -89.33  |  |
| 44.7000         | 18.15  | 95.60  | -89.91  |  |
| 44.8000         | 17.82  | 95.77  | -90.43  |  |
| 44.9000         | 17.49  | 95.93  | -90.88  |  |
| 45.0000         | 17.17  | 96.08  | -91.28  |  |
| 45.1000         | 16.86  | 96.23  | -91.61  |  |
| 45.2000         | 16.56  | 96.38  | -91.89  |  |
| 45.3000         | 16.26  | 96.52  | -92.11  |  |
| 45.4000         | 15.96  | 96.66  | -92.28  |  |

次に、この実施例における動作を、第5図A~ Cに示す各光路での偏光状態およびジョーンズベクトルを参照しながら説明する。

第5図Aに示す半導体レーザ11からの出射光を、 ビームスプリッタ13に対してP偏光で入射させる と、ビームスプリッタ13のコーティング13bによ りP. S偏光成分間に位相差があっても、S偏光

**- 1 5 -**

- 16 -

成分が容であるため、第 5 図 B に示すように P 偏 光のまま透過し、その振幅は√1pとなる。

次に、対物レンズ15を通った光が光磁気記録媒 体16に入射すると、その反射光は光磁気記録媒体 16に記録されている情報すなわち磁化の向きに応 じて、第5図Cに示すように±θk のカー回転を 受ける。この反射光が再びピームスプリック13に 入射して、そのコーティング13b を設けた反射面 13a で反射されると、該入射光にはS偏光成分が 存在するため位相が90°ずれ、したがって±θk 回転した光は第5図Dに示すように右回りと左回 りの同じ大きさの楕円偏光となる。その後、1/4 波長板17を通ることにより、楕円偏光の回転の向 きに応じて、第5図Bに示すように同一方向に回 転し、長軸の方向が直交する楕円偏光となり、次 に偏光ビームスプリッタ18によりその透過光およ び反射光がそれぞれ第2図FおよびCに示すよう に逆相となって光検出器19aおよび19bに入射す

この実施例によれば、1/4 波長板17の方位のず

れαによる影響は、信号光強度についてはcos2 α に比例し、差動アンバランス量については(4)式で 表わされるようになるので、第1実施例と同様の 効果がある。

なお、第3実施例においては、P偏光成分およびS偏光成分間に90°の位相差を発生させるコーティング13bをビームスプリッタ13の反射面13aに設けたが、光磁気記録媒体16と1/4 波長板17との間の戻り光路中に他の反射面を設けてこれにコーティング13bを設けるようにしても良い。

#### 〔発明の効果〕

上述したように、この発明によれば、光学系の 調整娯差による再生信号のC/Nの低下を大幅に軽 波できるので、光学系の組立てを容易にでき、調 整コトスを有効に低減できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の第1実施例を示す図、

第2図A~Iはその動作を説明するための図、

第3図はこの発明の第2実施例を示す図、

第4図は同じくこの発明の第3実施例を示す図、

第5図A~Cはその動作を説明するための図、 第6図および第7図A~Gは従来の技術を説明す るための図である。

11……半導体レーザ

12…コリメータレンズ

13----ピームスプリッタ 13a ----反射面

13b ----コーティング 14----1/4 波長板

15……対物レンズ

16……光磁気記錄媒体

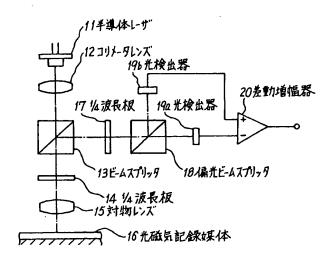
17…1/4 波县板

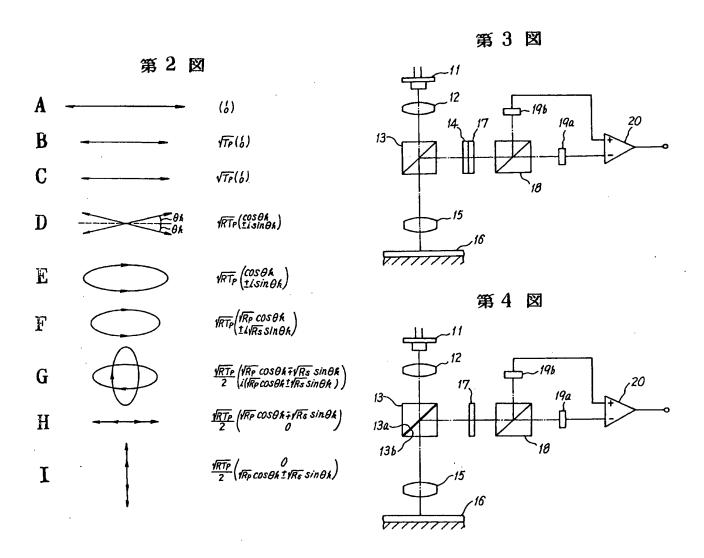
18……偏光ビームスプリッタ

19a, 19b·····光検出器 20·····差動增幅器

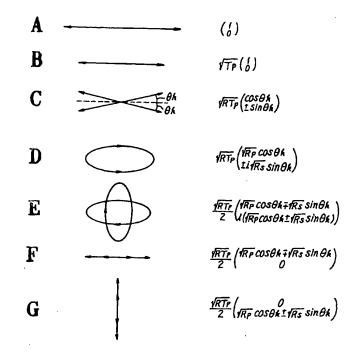
- 19-

### 第1図





### 第5図



## 第7図

